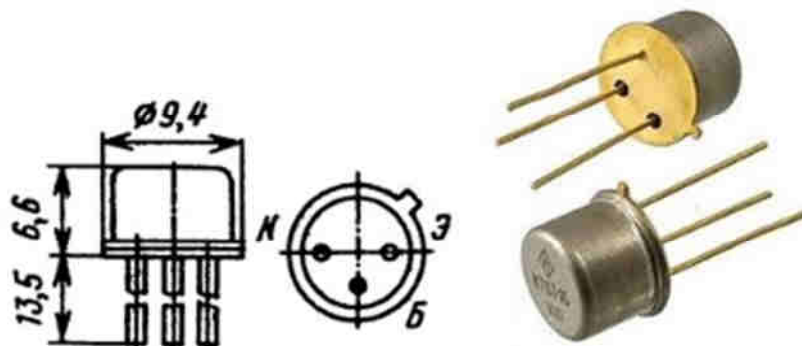


# ТРАНЗИСТОР КТ831В



Транзисторы КТ831В кремниевые мезазпитаксиально-планарные структуры n-p-n усилительные.

Предназначены для применения в усилителях мощности, преобразователях.

Корпус транзистора КТ831А, КТ831Б, КТ831В, КТ831Г металлический со стеклянными изоляторами и гибкими выводами.

Масса транзисторов не более 2 г.

Тип корпуса: КТ-2 (ТО-39).

Технические условия: АДБК.432150.125 ТУ.

## Основные технические характеристики транзистора КТ831В:

- Структура транзистора: n-p-n;
- $P_{к\text{т max}}$  - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 5 Вт;
- $f_{гр}$  - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 МГц;
- $U_{кб\text{о max}}$  - Максимальное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера: 40 В;
- $I_{к\text{ max}}$  - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 2 А;
- $h_{21э}$  - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: более 20;
- $R_{кэ\text{ нас}}$  - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,6 Ом